



Россия, г. Орел, ОАО "Протон"

**Микросхемы интегральные
КР249КН501**

Э Т И К Е Т К А

Микросхемы интегральные гибридные КР249КН501 предназначены для работы в качестве ключа с электрической изоляцией между входными и выходными выводами микросхемы.

Схема расположения выводов

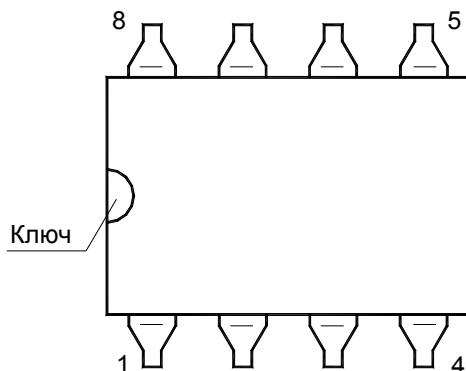


Таблица назначения выводов микросхемы КР249КН501

Номер вывода		Назначение вывода
I канал	II канал	
1	3	Анодный вывод излучающего диода
2	4	Катодный вывод излучающего диода
8	6	Коллектор фототранзистора
7	5	Эмиттер фототранзистора

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
Выходное остаточное напряжение, В $I_{вх} = 10 \text{ мА}; I_{ком} = 2 \text{ мА}$	$U_{вых.ост}$		0,4	от минус 45 до 70
Входное напряжение, В $I_{вх} = 10 \text{ мА}$	$U_{вх}$		1,8	от минус 45 до 70
Ток утечки, мкА $U_{ком} = 60 \text{ В}$	$I_{ут.вых}$		10	25
			100	70
Коэффициент передачи по току $U_{ком} = 10 \text{ В}, I_{вх} = 10 \text{ мА}$	k_i	0,5		от минус 45 до 70
Время задержки распро- странения сигнала при включении и выключении, мкс $I_{вх.и} = 10 \text{ мА}, U_{ком} = 10 \text{ В},$ $f = 10 \text{ кГц}, R_n = 5 \text{ кОм},$ $\tau_{вх \text{ имп}} = 5 \text{ мкс},$ $\tau_{ф.вх} = \tau_{сп.вх} = 0,1 \text{ мкс}$	$t^{0,1}_{зд.р}$		5	25
	$t^{1,0}_{зд.р}$			

Проходная емкость, пФ	Спр		5	25
Сопротивление изоляции, Ом U _{из} = 500 В	Риз	1x10 ¹²		25
Напряжение изоляции, В КР249КН501А КР249КН501Б КР249КН501В КР249КН501Г	U _{из} *	5000 3000 1500 500		25

Примечание: Все параметры указаны для каждого канала.
* В течение 1 мин. при относительной влажности воздуха ≤ 50%.
Контролируемый ток не должен превышать 10 мкА.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем.

Золото _____ г

Серебро _____ г

На выводах драгоценных металлов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные _____ соответствуют
тип микросхемы

техническим условиям _____
наименование ТУ

Штамп ОТК

Указания по применению и эксплуатации.

Допустимое значение статического потенциала - 500В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265°С продолжительностью не более 3с.

Число допустимых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более 2.

Режим и условия монтажа микросхем в аппаратуре – по ОСТ 11 073.063.

Допускается воздействие обратного напряжения на вход микросхемы с амплитудой не более 3,5В, длительностью не более 10мкс.

Маркировка микросхем: тип изделия - КН501

типономинал - А, Б, В, Г.

Год и месяц изготовления - буквенное и цифровое обозначение по ГОСТ 30668.

Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления
2000	М	2007	V	2014	E
2001	N	2008	W	2015	F
2002	P	2009	X	2016	H
2003	R	2010	A	2017	I
2004	S	2011	B	2018	K
2005	T	2012	C	2019	L
2006	U	2013	D	2020	M

Месяц изготовления	январь-сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Код месяца изготовления	1÷9	O	N	D